# \_\_\_\_\_ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ \_\_ И НАНОМАТЕРИАЛЫ

УДК 544.72.05:546.06

# СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>

© 2023 г. А. Ф. Гусева<sup>*a*</sup>, Н. Н. Пестерева<sup>*a*</sup>, \*

<sup>а</sup>Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, ул. Мира, 19, Екатеринбург, 620002 Россия \*e-mail: Natalie.Pestereva@urfu.ru Поступила в редакцию 05.09.2022 г. После доработки 17.10.2022 г.

Принята к публикации 18.10.2022 г.

Твердофазным методом получены композиты  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3-xSiO_2$  с мольной долей оксида кремния  $x \le 0.5$ . Фазовый состав композитов и их термодинамическая стабильность подтверждены соответственно методами рентгенофазового анализа и термогравиметрии в совокупности с дифференциальной сканирующей калориметрией. Методом сканирующей электронной микроскопии в совокупности с энергодисперсионным анализом исследована морфология композитов. Электропроводность композитов, измеренная методом электрохимического импеданса, исследована в зависимости от температуры, давления кислорода в газовой фазе и содержания дисперсной добавки – оксида кремния. Изучены температурные зависимости суммы ионных чисел переноса композитов методом ЭДС, установлен ионный характер проводимости композитов. Обнаружен композитный эффект проводимости в исследуемой системе: добавление 30 мол. % нанодисперсного оксида кремния к вольфрамату неодима приводит к росту ионной проводимости более чем на два порядка.

*Ключевые слова:* гетерогенное допирование, вольфрамат неодима, нанодисперсный оксид кремния, композитный эффект проводимости, композитные твердые электролиты **DOI:** 10.31857/S0044457X2260164X, **EDN:** JDTXFT

## введение

Вольфраматы редкоземельных металлов  $Ln_2(WO_4)_3$  (Ln = La, Sm, Eu, Gd, Nd) co структурой дефектного шеелита широко используются в технике как компоненты лазерных материалов и катализаторов [1-6]. Недавние исследования показали, что у этих веществ может быть еще одно интересное применение, связанное с их электрическими свойствами. В работе [7] установлено, что основными носителями заряда в этих веществах являются ионы кислорода. Однако ионная проводимость вольфраматов РЗЭ слишком низкая для практического применения. Эффективным методом увеличения ионной проводимости является гетерогенное допирование вешеств высокодисперсными инертными добавками, такими как SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub> и т.д. [9, 10]. Композитный эффект (резкий скачок ионной проводимости гетерогенной системы при небольшом содержании гетерогенной добавки) дает возможность расширить выбор твердых электролитов с различными функциональными свойствами и решить проблему улучшения их эксплуатационных характеристик, что является актуальной задачей.

Причины высокой ионной проводимости композитов, требования, предъявляемые к составляющим композита — веществам матрицы и дисперсной добавки, к настоящему времени хорошо исследованы и подробно описаны в литературе [8-11], особенно для ионных солей. Что касается вольфраматных систем, то наиболее подробно исследованы композиты на основе вольфраматов щелочноземельных металлов с дисперсной добавкой WO<sub>3</sub>. В работах А.Я. Неймана с соавт. показано, что добавление всего 1–2 об. %  $WO_3$  к  $MWO_4$  (M = Ca, Sr, Ba) приводит к росту кислородно-ионной проводимости на 1.5 порядка. Полученные данные были объяснены в рамках модели, представляющей композит как матричную распределенную систему, в которой роль связной матрицы выполняет поверхностная фаза MW-s с высокой концентрацией вакансий кислорода и, как следствие, высокой подвижностью ионов кислорода [12, 13]. Аналогичный эффект был обнаружен для системы Sm<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>-WO<sub>3</sub>. Дисперсная добавка – оксид вольфрама – обладает низкой поверхностной энергией, вследствие чего легко распространяется по поверхности зерен матрицы (вольфрамата металла), образуя пленку высокопроводящей микрофазы, ответственной за высокую ионную проводимость композитов [14].

Влияние инертной дисперсной добавки с высокой поверхностной энергией  $(Al_2O_3, SiO_2)$ , не склонной к твердофазному растеканию, на ион-

ную проводимость "вольфраматных" композитов менее изучено. Имеются работы по исследованию композитного эффекта в системах  $Al_2(WO_4)_3 - Al_2O_3$ [15–17], CaWO<sub>4</sub>–SiO<sub>2</sub> [18] и La<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>–SiO<sub>2</sub> [19]. Во всех работах отмечен рост ионной проводимости на 0.5-1 порядок при гетерогенном допировании вольфраматов нанооксидами кремния или алюминия. Концентрационная зависимость проводимости имеет куполообразный вид, характерный для композитов ионный проводник-диэлектрик, и трактуется в рамках перколяционной теории [8].

Для расширения круга объектов и углубления знаний о процессах на межфазной границе матрица/дисперсоид в настоящей работе предпринята попытка синтезировать композиты на основе вольфрамата неодима  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2 c$ мольной долей нанодисперсного оксида кремния  $x \le 0.5$  и исследовать их термодинамическую стабильность, морфологию и электротранспортные свойства. Выбор данной системы обусловлен следующими соображениями. Вольфраматы лантана и неодима изоструктурны, и поскольку в исследованной ранее системе  $La_2(WO_4)_3$ -SiO<sub>2</sub> обнаружен композитный эффект проводимости [19], его можно ожидать и в системе  $Nd_2(WO_4)_3$ -SiO<sub>2</sub>. Кроме того, электропроводность Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> выше, чем La<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, что позволяет надеяться на бо́льшую ионную проводимость композитов на основе вольфрамата неодима.

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Вольфрамат неодима Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> синтезировали твердофазным методом из Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и WO<sub>3</sub> квалификации "ос. ч.". Синтез проводили на воздухе по уравнению:

$$Nd_2O_3 + 3WO_3 \rightarrow Nd_2(WO_4)_3.$$
(1)

Смесь реагентов, взятых в стехиометрических количествах, нагревали на воздухе с постепенным повышением температуры от 700 до 1050°С в четыре приема с промежуточными перетираниями в среде этанола. Время отжига на каждом этапе варьировалось от 25 (при 700 и 800°С) до 85 ч (при 900 и 1050°С).

Композиты  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2$ , где x -мольная доля SiO<sub>2</sub>, получали механическим смешением порошков вольфрамата неодима и кремнезема. В качестве дисперсной добавки использовали коллоидный диоксид кремния высокой чистоты (Aerosil-300, фирма Degussa) с содержанием SiO<sub>2</sub> 99.9%. По данным производителя [20], удельная поверхность нанодисперсного порошка составляет 300 м<sup>2</sup>/г, а средний размер частиц – 7 нм. Тщательно перетертые в среде этилового спирта смеси порошков  $Nd_2(WO_4)_3$  и SiO<sub>2</sub> прессовали в дисковые таблетки диаметром 10 мм и толщиной 2 мм под давлением 64 МПа и спекали в течение 24 ч при 1000°С. Относительная плотность брикетов композитов, рассчитанная по их размерам и массе, варьировалась в пределах 88-97% в зависимости от содержания SiO<sub>2</sub>. Для проведения электрических измерений на поверхности таблеток наносили пористые Pt-электроды, которые припекали при 1000°С в течение 1 ч.

Рентгенофазовый анализ вольфрамата неодима и композитов на его основе выполняли на дифрактометре Bruker D8 Advance в Cu $K_{\alpha}$ -излучении.

Исследование морфологии композитов и их элементного состава проводили методами электронной микроскопии и энергодисперсионного анализа (СЭМ–ЭДА) сколов брикетов образцов на сканирующем электронном микроскопе Еvo LS-10 Carl Zeiss NTS (УЦКП "Современные нанотехнологии" УрФУ ИЕНиМ УрФУ). Изображения поверхности исследуемых материалов были получены с использованием детекторов обратнорассеянных (режим BSE) и вторичных электронов (режим SE).

Синхронные термические анализы (ТГ и ДСК) проводили на приборе Netzsch STA 409 PC Luxx с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403 Aeolos. Эквимолярную смесь порошков Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> и SiO<sub>2</sub> нагревали до 1000°С.

Электропроводность вольфрамата неодима и композитов  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2$  измеряли методом импедансной спектроскопии с помощью прибора Immittance Parameters Meter IPI1 (Институт проблем управления им. Трапезникова, Москва) в частотном диапазоне 500 Гц-200 кГц (амплитуда тестового сигнала автоматически изменяется в диапазоне 3-300 мВ) в интервале температур 500-900°С. Снятие температурной зависимости электропроводности осуществляли в режиме охлаждения со скоростью 1 град/мин. Зависимость проводимости от парциального давления кислорода измеряли в изотермических условиях. Давление кислорода задавали с помощью прибора ZirconiaM и контролировали кислородным насосом и датчиком из твердого электролита на основе  $ZrO_2$  ( $Y_2O_3$ ).

Для определения суммы ионных чисел переноса композитов использовали метод ЭДС, основанный на использовании концентрационных гальванических цепей. Для реализации градиента парциального давления кислорода один из электродов принудительно омывали кислородом  $(P_{O_2}^{\prime\prime}=1 \text{ атм.}),$ а другой — воздухом ( $P_{O_2}^{\prime}=0.21 \text{ атм.})$ с помощью микрокомпрессора. Скорость подачи газов к электродам была постоянной. Изоляции газовых пространств электродов добивались тщательной шлифовкой таблеток и прижатием образца к алундовой трубке. Сумму ионных чисел переноса



Рис. 1. Результаты рентгенофазового анализа  $Nd_2(WO_4)_3$ , SiO<sub>2</sub> и композита  $0.5Nd_2(WO_4)_3$ – $0.5SiO_2$ .

вычисляли по формуле Нернста для проводников со смешанной проводимостью:

$$E = \frac{RT}{4F} \Sigma t_{\text{ион}} \ln \frac{P_{O_2}^{//}}{P_{O_2}^{/}},$$
 (2)

где R — молярная газовая постоянная; T — температура, К; F — постоянная Фарадея;  $\Sigma t_{ион}$  — сумма ионных чисел переноса;  $P_{O_2}^{//}$  — парциальное давление кислорода, равное 1 атм.;  $P_{O_2}^{/}$  — парциальное давление кислорода, равное 0.21 атм.

# РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

РФА. По данным рентгенофазового анализа, получен однофазный вольфрамат неодима и двухфазные композиты  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2$ , содержащие только исходные компоненты –  $Nd_2(WO_4)_3$  и SiO<sub>2</sub> (рис. 1), т.е. химического взаимодействия веществ, входящих в состав композита, не происходит.

Рентгенограмма SiO<sub>2</sub> представлена размытым максимумом при  $2\theta = 22.0^{\circ}$ , который является характерным для аморфного SiO<sub>2</sub> (JCPDS № 29-0085), а также рефлексами кварца:  $2\theta = 28.7^{\circ}$ ,  $33.3^{\circ}$  (JCPDS № 83-540). На рентгенограмме композита  $0.5Nd_2(WO_4)_3$ - $0.5SiO_2$  присутствуют все рефлексы вольфрамата неодима, а также размытый пик аморфного SiO<sub>2</sub> при 22°, остальные рефлексы SiO<sub>2</sub> ( $2\theta = 28.7^{\circ}$ ,  $33.3^{\circ}$ ) совпадают с рефлексами вольфрамата неодима:  $2\theta = 27.7^{\circ}$ ,  $29^{\circ}$ ,  $33.12^{\circ}$  (PDF-2 № 00-019-0829) (на рис. 1 показаны стрелками). Рефлексы посторонних фаз на рентгенограмме композита не обнаружены, что ука-



**Рис. 2.** Данные ТГ-ДСК смеси 0.5Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>-0.5SiO<sub>2</sub>.

зывает на отсутствие взаимодействия между компонентами композита.

**ТГА и ДСК.** Результаты термогравиметрического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии эквимолярной смеси  $Nd_2(WO_4)_3$  и SiO<sub>2</sub> представлены на рис. 2, из которого видно, что во всем исследованном температурном интервале (70–1000°С) масса смеси вольфрамата неодима и оксида кремния не изменяется и тепловые эффекты не наблюдаются. Эти данные свидетельствуют о термодинамической стабильности композитов: при температуре до 1000°С химического взаимодействия между компонентами композита не происходит.

Таким образом, двумя независимыми методами (ТГ-ДСК и РФА) установлено отсутствие химического взаимодействия между компонентами композитов  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2$ .

СЭМ и ЭДА. Морфология композитов и их элементный состав исследованы методом СЭМ-ЭДА. СЭМ-изображения сколов брикетов композитов различного состава и результаты ЭДА представлены на рис. 3.

На СЭМ-изображениях сколов брикетов композитов  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3-xSiO_2$  видны крупные зерна вольфрамата неодима размером 5–20 мкм и мелкие зерна SiO<sub>2</sub> (или, возможно, конгломераты зерен) размером ~0.1–1 мкм. При небольшом содержании кремнезема (10 мол. %) на СЭМ-изображениях видны отдельные зерна SiO<sub>2</sub> или их цепи, которые они образуют вокруг зерен Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (рис. 3а); при большем содержании кремнезема (30 мол. %) крупные зерна Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> равномерно окружены мелкими зернами SiO<sub>2</sub> (рис. 36).





**Рис. 3.** СЭМ-изображение и результаты ЭДА сколов брикетов композитов:  $a - 0.90 Nd_2 (WO_4)_3 - 0.10 SiO_2$ ,  $6 - 0.70 Nd_2 (WO_4)_3 - 0.30 SiO_2$ .

Энергодисперсионный анализ (рис. 3а) показал наличие Nd, W и O и отсутствие Si на поверхности крупных зерен, что позволяет идентифицировать их как вольфрамат неодима. Спектр ЭДА мелких зерен, напротив, показывает наличие всех элементов, что с учетом рассеяния пучка позволяет их идентифицировать как SiO<sub>2</sub>.

На СЭМ-изображениях сколов брикетов композитов замечено, что мелкие зерна  $SiO_2$  втягиваются (проваливаются) в крупные зерна  $Nd_2(WO_4)_3$ . Зерна вольфрамата неодима "обволакивают" мелкие зерна кремнезема, втягивая их в себя. Аналогичный эффект (поглощение крупными зернами вольфраматов мелких зерен дисперсной добавки) наблюдался нами ранее в системах  $Al_2(WO_4)_3$ – $Al_2O_3$  [15], CaWO<sub>4</sub>–SiO<sub>2</sub> [18] и La<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>–SiO<sub>2</sub> [19].

#### Исследование электропроводности композитов в зависимости от температуры, содержания оксида кремния и парциального давления кислорода в газовой фазе

Политермы проводимости  $Nd_2(WO_4)_3$  и композитов  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2$  представлены на рис. 4. Эффективная энергия активации проводимости композитов составляет 0.9–1.1 эВ во всем исследованном температурном интервале. Близость энергии активации проводимости к 1 эВ косвенно свидетельствует о кислородно-ионном характере проводимости [21].

Концентрационная зависимость проводимости композитов  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2$  представлена на рис. 5. Она имеет вид кривой с максимумом. Такой "куполообразный" вид концентрационной зависимости проводимости, характерный для систем



Рис. 4. Зависимость электропроводности композитов  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2$  от обратной температуры.

ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ том 68 № 3 2023



**Рис. 5.** Зависимость электропроводности композитов  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2$  от мольной доли SiO<sub>2</sub> при разных температурах.

ионная соль-диэлектрик, подробно описан в литературе [8] и объясняется в рамках перколянионной модели. Однако полученная в настоящей работе зависимость имеет некоторые особенности. Так, добавление до 20 мол. % кремнезема к вольфрамату неодима не приводит к существенному изменению электропроводности. С учетом разброса, характерного для гетерогенных систем, значения электропроводности композитов, содержащих до 20 мол. % SiO<sub>2</sub>, близки. Резкий рост проводимости происходит при добавлении к вольфрамату неодима >20 мол. % SiO<sub>2</sub>. Максимум проводимости наблюдается для состава  $0.7 \text{Nd}_2(WO_4)_3 - 0.3 \text{SiO}_2$ . Электропроводность композита, содержащего 30 мол. % кремнезема, более чем на два порядка выше электропроводности  $Nd_2(WO_4)_3$ .

Для установления природы проводимости композитов была исследована зависимость электропроводности композитов от парциального давления кислорода в газовой фазе (рис. 6).

Как видно из рис. 6, проводимость вольфрамата неодима и композита на его основе не зависит от  $P_{\Omega_2}$ , что указывает на ее ионный характер.

#### Исследование суммы ионных чисел переноса методом ЭДС

Для подтверждения ионного характера проводимости композитов в работе методом ЭДС были измерены ионные числа переноса композитов. Температурные зависимости  $\Sigma t_{ион} \text{ Nd}_2(\text{WO}_4)_3$  и композита 0.75Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>-0.25SiO<sub>2</sub> представлены на табл. 7.



**Рис. 6.** Зависимость электропроводности  $Nd_2(WO_4)_3$  и композита  $0.75Nd_2(WO_4)_3-0.25SiO_2$  от парциального давления кислорода в газовой фазе при разных температурах.



Рис. 7. Температурная зависимость суммы ионных чисел переноса  $Nd_2(WO_4)_3$  и композита  $0.75Nd_2(WO_4)_3$ – $0.25SiO_2$ .

Сумма ионных чисел переноса вольфрамата неодима и композита  $0.75 \text{Nd}_2(WO_4)_3 - 0.25 \text{SiO}_2$  составляет 0.75 - 0.85. С учетом того, что  $\Sigma t_{ион}$ , измеренная методом ЭДС, всегда имеет заниженное значение для керамики (поскольку из-за открытой пористости брикетов кислород диффундирует через образец), можно полагать, что в композите, как и в вольфрамате неодима, доминирует ионный перенос.

Таким образом, двумя независимыми методами (исследование зависимости электропроводности от давления кислорода в газовой фазе и измерение чисел переноса методом ЭДС) установлен преимущественно ионный характер проводимости композитов на основе вольфрамата неодима. Поскольку матрица композитов  $Nd_2(WO_4)_3$ , как и другие вольфраматы P3Э со структурой дефектного шеелита, является кислородно-ионным проводником [7], а SiO<sub>2</sub> – диэлектриком, можно предположить, что и в композитах  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3$ -xSiO<sub>2</sub> носителями заряда также являются ионы кислорода.

В литературе описано множество проявлений композитного эффекта: рост ионной проводимости [8–19, 22], улучшение спекания и увеличение механической прочности [8, 23, 24], возрастание сорбционных свойств [25], улучшение электрохимических характеристик катодных материалов [26, 27], рост газочувствительности полупроводниковых датчиков [28]. Существует множество теорий, объясняющих неаддитивное изменение различных физико-химических свойств композитов по сравнению с компонентами, но все они так или иначе связаны со свойствами межфазных границ матрица-дисперсоид. Так, рост ионной проводимости при гетерогенном допировании ионопроводящей матрицы инертной высокодисперсной добавкой связывают с вкладом межфазных границ в суммарную проводимость композита [8-11]. Называют следующие процессы на межфазных границах, приводящие к высокой ионной композитной проводимости: увеличение концентрации и подвижности дефектов на межфазной границе, образованной компонентами композита [8, 29], аморфизация матрицы вблизи межфазной границы [30-33], образование неавтономной поверхностной микрофазы [12, 13, 34].

Таким образом, рост электропроводности композитов  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2 c$  увеличением содержания кремнезема связан с высокой ионной проводимостью межфазной границы  $Nd_2(WO_4)_3$ SiO<sub>2</sub>, образующейся в месте контакта матрицы и дисперсной добавки. Сегрегация мелких зерен SiO<sub>2</sub> в приповерхностной области крупных зерен матрицы вольфрамата неодима, обнаруженная в данной работе методом СЭМ-ЭДА. способствует образованию связной системы проводящих межфазных границ Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>SiO<sub>2</sub>. Причиной втягивания зерен оксида кремния в зерна вольфрамата неодима, по-видимому, является разница поверхностной энергии данных веществ. Кремнезем – тугоплавкое вещество с высокой поверхностной энергией ( $\gamma = 68 \ \text{Дж/м}^2$ [35]), поэтому для уменьшения энергии системы выгодно покрывание его поверхности другим веществом с более низкой поверхностной энергией. Мелкие частицы кремнезема проникают через поверхность зерен вольфрамата неодима, "обволакиваются" им, образуя специфический поверхностный слой, состоящий из мелких зерен SiO<sub>2</sub>, покрытых Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. При последовательном увеличении содержания оксида кремния в композитах в пределах до 20 мол. % идет постепенное его накопление в приповерхностных областях зерен Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, на СЭМ-изображениях (рис. 3а) видны отдельные изолированные зерна или их цепи, сплошная пленка межфазных границ еще не образуется, поэтому проводимость композитов (1 - x)Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>-xSiO<sub>2</sub> с x < 0.2 меняется слабо. По-видимому, 20 мол. % – минимальное содержание оксида кремния в композите, необходимое для образования сплошной пленки высокопроводящих межфазных границ Nd<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>SiO<sub>2</sub>. Об этом свидетельствует резкий рост проводимости композитов начиная с 20 мол. % SiO<sub>2</sub>, а также данные СЭМ, согласно которым в композитах, содержащих >20% кремнезема, зерна  $Nd_2(WO_4)_3$  полностью окружены зернами SiO<sub>2</sub>.

Проходя через максимум, соответствующий 30 мол. % SiO<sub>2</sub>, электропроводность начинает снижаться из-за разрыва сплошности межфазной границы частицами диэлектрика SiO<sub>2</sub>.

Таким образом, в системе  $Nd_2(WO_4)_3$ —SiO<sub>2</sub> имеет место композитный эффект проводимости; гетерогенное допирование вольфрамата неодима высокодисперсным кремнеземом позволило получить твердый электролит с высокой кислородной проводимостью.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Твердофазным методом получены композиты  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3 - xSiO_2$ . Методами РФА и ТГ-ДСК установлено отсутствие химического взаимодействия между компонентами композитов. Измерение суммы ионных чисел переноса методом ЭДС и исследование зависимости электропроводности композитов от давления кислорода в газовой фазе показало, что они обладают преимущественно ионной проводимостью.

Концентрационные зависимости проводимости композитов  $(1 - x)Nd_2(WO_4)_3-xSiO_2$  имеют вид кривой с максимумом. Введение 30 мол. % дисперсной добавки приводит к увеличению проводимости в системе  $Nd_2(WO_4)_3-SiO_2$  более чем на два порядка. Таким образом, в исследуемой системе имеет место композитный эффект проводимости. Рост ионной проводимости при гетерогенном допировании вольфрамата неодима высокодисперсным кремнеземом обусловлен образованием связно-дисперсной системы проводящих межфазных границ  $Nd_2(WO_4)_3|SiO_2$  в результате сегрегации мелких зерен  $SiO_2$  в приповерхностной области крупных зерен матрицы вольфрамата неодима.

#### ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Результаты исследований получены в рамках выполнения государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (номер проекта FEUZ-2023-0016) с использованием оборудования УЦКП "Современные нанотехнологии" УрФУ (рег. № 2968), поддержанным Министерством науки и высшего образования РФ (проект № 075-15-2021-677).

#### КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Boulon G., Metrat G., Muhlstein N. et al.* // Conference on New Laser Technologies and Applications. 2003. https://doi.org/10.1117/12.513519
- Zhou Y., Yan B. // CrystEngComm. 2013. V. 15. № 28. P. 5694.
- https://doi.org/10.1039/c3ce40495a
- Kaczmarek A.M., Van Deun R. // Chem. Soc. Rev. 2013. V. 42. № 23. P. 8835. https://doi.org/10.1039/c3cs60166h
- Guzik M., Tomaszewicz E., Guyot Y. et al. // J. Mater. Chem. C. 2015. V. 3. № 16. P. 4057. https://doi.org/10.1039/c4tc02963a
- Liu J., Kaczmarek A.M., Van Deun R. // Chem. Soc. Rev. 2018. V. 47. P. 7225. https://doi.org/10.1039/c7cs00893g
- Ke J., Adnan Younis M., Kong Y. et al. // Nano-Micro Letters. 2018. V. 10. № 4. https://doi.org/10.1007/s40820-018-0222-4
- Pestereva N., Guseva A., Vyatkin I., Lopatin D. // Solid State Ionics. 2017. V. 301. P. 72. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2017.01.009
- 8. *Уваров Н.Ф.* Композиционные твердые электролиты. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. 258 с.
- 9. *Knauth P.* // J. Electroceram. 2000. V. 5. № 2. P. 111. https://doi.org/10.1023/a:1009906101421
- Yaroslavtsev A.B. // Russ. Chem. Rev. 2009. V. 78. № 11. P. 1013.
- Mateyshina Y., Slobodyuk A., Kavun V., Uvarov N. // Solid State Ionics. 2018. V. 324. P. 196. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2018.04.026
- 12. Нейман А.Я., Пестерева Н.Н., Шарафутдинов А.Р. и др. // Электрохимия. 2005. Т. 41. С. 680.
- Пестерева Н.Н., Жукова А.Ю., Нейман А.Я. // Электрохимия. 2007. Т. 43. С. 1379.
- Гусева А.Ф., Пестерева Н.Н., Востротина Е.Л. и др. // Электрохимия. 2020. Т. 56. № 5. С. 475. https://doi.org/10.31857/S0424857020050035
- 15. Гусева А.Ф., Пестерева Н.Н., Отческих Д.Д., Востротина Е.Л. // Электрохимия. 2019. Т. 55. № 6. С. 721.
- Köhler J., Kobayashi Y., Imanaka N., Adachi G. // Solid State Ionics. 1998. V. 113–115. P. 553. x https://doi.org/10.1016/S0167-2738(98)00321-
- 17. *Köhler J., Imanaka N., Adachi G. //* Mater. Sci. Forum. 1999. V. 315–317. P. 537.

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.315-317.537

- Guseva A.F., Pestereva N.N., Otcheskikh D.D., Kuznetsov D.V. // Solid State Ionics. 2021. V. 364. P. 115626. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2021.115626
- Гусева А.Ф., Пестерева Н.Н., Пырлик Е.В., Корона Д.В. // Неорган. материалы. 2022. Т. 58. № 6. С. 633.
- 20. Technical Bulletin Fine Particles № 11/ Basic Characteristics of Aerosil Fumed Silica. 4th ed. Essen: Evonik, 2003.
- 21. Чеботин В.Н., Перфильев М.В. Электрохимия твердых электролитов. М.: Химия, 1978. 312 с.
- 22. Veer D., Kumar P., Singh D. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. P. 2059. https://doi.org/10.1134/S003602362114014X
- Titov D.D., Shcherbakova G.I., Gumennikova E.A. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. P. 1141. https://doi.org/10.1134/S0036023621080295
- 24. Obolkina T.O., Goldberg M.A., Antonova O.S. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2021. V. 66. P. 1223. https://doi.org/10.1134/S0036023621080192
- Tkachenko I.A., Panasenko A.E., Odinokov M.M. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. P. 1142. https://doi.org/10.1134/S0036023620080173
- Medvedeva A.E., Pechen L.S., Makhonina E.V. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. P. 829. https://doi.org/10.1134/S003602361907012X
- Kaimieva O.S., Kruzhkov D.A., Buyanova E.S. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. P. 158. https://doi.org/10.1134/S0036023619020104
- Haiduk Y.S., Savitsky A.A., Khort A.A. // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. P. 717. https://doi.org/10.1134/S003602361906007X
- 29. Uvarov N.F., Ulikhin A.S., Mateishina Yu.G. // Chemistry for Sustainable Development 20. 2012. P. 69.
- Mateyshina Y., Uvarov N. // Solid State Ionics. 2018.
  V. 324 P. 1. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2018.05.017
- Ulihin A.S., Uvarov N.F., Rabadanov K.S. et al. // Solid State Ionics. 2022. V. 378. 115889. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2022.115889
- Ulikhin A.S., Uvarov N.F., Kovalenko K.A., Fedin V.P. // Microporous Mesoporous Mater. 2022. V. 332. 111710. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2022.111710
- Улихин А.С., Уваров Н.Ф. // Электрохимия. 2021. Т. 57. № 10. С. 608.
- 34. Neiman A.Ya., Uvarov N.F., Pestereva N.N. // Solid State Ionics. 2007. V. 177. P. 3361. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2006.10.006
- Wong P.L., Li X.M., Guo F. // Tribology Int. 2013. V. 61. P. 116. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2012.12.009